

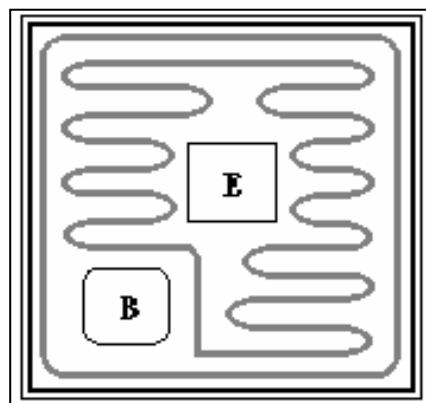


## 8050 晶体管芯片说明书

## 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）  
芯片代码：C060AJ-00  
芯片厚度： $240 \pm 20\mu\text{m}$   
管芯尺寸： $600 \times 600\mu\text{m}^2$   
焊位尺寸：B 极  $130 \times 150\mu\text{m}^2$ ；E 极  $140 \times 130\mu\text{m}^2$   
电极金属：铝  
背面金属：金  
典型封装：S8050，H8050

## 管芯示意图

极限值（ $T_a=25$ ）（封装形式：TO-92）

$T_{\text{stg}}$ ——贮存温度.....	-55~150
$T_j$ ——结温.....	150
$P_C$ ——集电极耗散功率.....	1W
$V_{\text{CBO}}$ ——集电极—基极电压.....	40V
$V_{\text{CEO}}$ ——集电极—发射极电压.....	25V
$V_{\text{EBO}}$ ——发射极—基极电压.....	6V
$I_C$ ——集电极电流.....	1.2A

电参数（ $T_a=25$ ）（封装形式：TO-92）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
$I_{\text{CBO}}$	集电极—基极截止电流			0.1	$\mu\text{A}$	$V_{\text{CB}}=35\text{V}$ ， $I_{\text{E}}=0$
$I_{\text{EBO}}$	发射极—基极截止电流			0.1	$\mu\text{A}$	$V_{\text{EB}}=6\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=0$
$h_{\text{FE}}$	直流电流增益	85		500		$V_{\text{CE}}=1\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=100\text{mA}$
		40				$V_{\text{CE}}=1\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=800\text{mA}$
$V_{\text{BE(ON)}}$	基极—发射极导通电压			1.0	V	$V_{\text{CE}}=1\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=10\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压			0.5	V	$I_{\text{C}}=800\text{mA}$ ， $I_{\text{B}}=80\text{mA}$
$V_{\text{BE(sat)}}$	基极—发射极饱和电压			1.2	V	$I_{\text{C}}=800\text{mA}$ ， $I_{\text{B}}=80\text{mA}$
$BV_{\text{CBO}}$	集电极—基极击穿电压	40			V	$I_{\text{C}}=100\mu\text{A}$ ， $I_{\text{E}}=0$
$BV_{\text{CEO}}$	集电极—发射极击穿电压	25			V	$I_{\text{C}}=2\text{mA}$ ， $I_{\text{B}}=0$
$BV_{\text{EBO}}$	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_{\text{E}}=100\mu\text{A}$ ， $I_{\text{C}}=0$
$f_{\text{T}}$	特征频率	100			MHz	$V_{\text{CE}}=10\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=50\text{mA}$